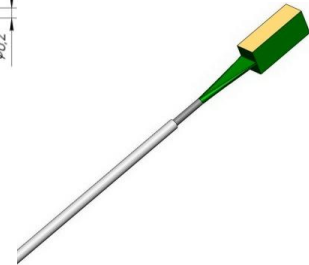
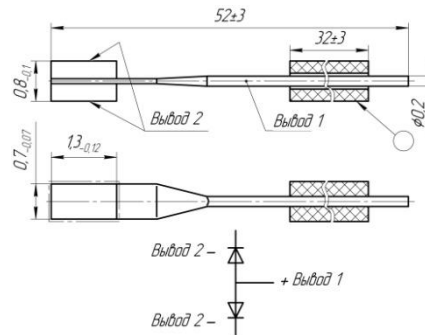


2A508A-1

Рабочий диапазон длин волн: сантиметровый и дециметровый;
 Рабочая температура окружающей среды: минус 60 °С ÷ 125 °С;
 Масса (не более): 0.05 г;
 Бескорпусное исполнение
 Технические условия: ТРЗ.360.077 ТУ

Диод полупроводниковый бескорпусной СВЧ кремниевый, созданный на базе диффузионной технологии, p-i-pn переключаемый типа 2A508A-1, предназначенный для работы в переключателях, модуляторах, фазовращателях, аттенуаторах и других изделиях сантиметрового и дециметрового диапазона длин волн в аппаратуре специального назначения.



Электрические параметры при нормальной температуре окружающей среды

Тип диода	Потери пропускания ¹⁾ , L _п (дБ)		Качество ¹⁾ , К	Время установления ²⁾ , τ _{уст} (мкс)	Время восстановления ²⁾ , τ _{вос} (мкс)
	при T _{окр} = 25 °С	при T _{окр} = минус 60 °С и 125 °С			
2A508A-1	≤ 0.4	≤ 0.6	≥ 600	≤ 6	≤ 40

Примечание: 1) При подводимой мощности P_{пд} = 1 Вт, λ = 3.2 см;

2) При токе I_и = 100 мА, частоте следования импульса f = 1000 Гц, длительности импульса τ = 100 мкс, сопротивлении нагрузки R_н = 100 Ом

Максимально допустимая рассеиваемая СВЧ мощность

(при T_{окр} от минус 60 °С до 60 °С)

– 1.5 Вт

Максимально допустимая коммутируемая импульсная СВЧ мощность

(при длительности импульса τ = 1 мкс, скважности в резонансной щели S = 1000)

– 0.8 кВт

Максимально допустимое постоянное обратное напряжение

(при T_{окр} от минус 60 °С до 85 °С)

– 100 В

Максимально допустимый постоянный прямой ток

(при T_{окр} от минус 60 °С до 85 °С)

– 500 мА